

Silicon Diode

BY197

Fast Rectifier

200V / 1,2A

DATASHEET

OEM – ITT Intermetall

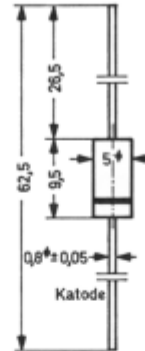
Source: ITT Intermetall Databook 73/74

BY 196...BY 199

Schnelle Silizium-Gleichrichter

Nennstrom	1,2 A
period. Spitzensperrspannung	100...800 V

Kunststoffgehäuse \approx DO-13
56 A 2 nach DIN 41 883
Gewicht ca. 0,6 g
Maße in mm



Grenzwerte	BY 196	BY 197	BY 198	BY 199	
period. Spitzensperrspannung U_{RRM}	100	200	400	800	V
Stoßstrom für eine 50-Hz-Sinus-halbwellen ausgehend von $T_j = 25\text{ °C}$		I_{FSM}	70		A
Sperrschichttemperatur		T_j	150		°C
Betriebs- und Lagerungstemperaturbereich		T_U, T_S	-40...+150		°C

Kennwerte			
Nennstrom in Einwegschaltung mit Widerstandslast bei $T_U = 50\text{ °C}$	I_{FAV}	1,2 1)	A
Durchlaßspannung bei $i_F = 3\text{ A}$, $T_j = 25\text{ °C}$	u_F	<1,3	V
Sperrstrom bei U_{RRM} , $T_j = 25\text{ °C}$	I_R	<10	μA
Durchlaßverzögerung bei $I_F = 100\text{ mA}$	t_{tr}	<1	μs
Sperrverzögerung beim Umschalten von $I_F = 10\text{ mA}$ auf $I_R = 10\text{ mA}$ bis $I_R = 1\text{ mA}$	t_{rr}	<0,5	μs
Wärmewiderstand Sperrschicht - umgebende Luft	R_{thU}	<60 1)	K/W

1) Dieser Wert gilt, wenn die Anschlußdrähte in 10 mm Abstand vom Gehäuse auf Umgebungstemperatur gehalten werden.